

新

# EC4A01C—N チャネル接合形シリコン電界効果トランジスタ コンデンサマイクロホン用

- 特長**

  - ・超小型（1008 サイズ）、薄型（0.6mm）リードレスパッケージ。
  - ・音響用、電話用コンデンサマイクとして最適である。
  - ・電圧特性が良い。
  - ・過度特性が良い。
  - ・FBET プロセス採用。

## 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25

ゲート・ドレイン電圧	VGDO	- 20	V
ゲート電流	IG	10	mA
ドレイン電流	ID	1	mA
許容損失	PD	100	mW
接合部温度	Tj	150	
保存周囲温度	Tstg	- 55 ~ + 150	

## 電氣的特性 Electrical Characteristics / Ta=25

<b>ゲート・ドレイン降伏電圧</b>	V(BR)GDO	I <sub>G</sub> = - 100μA	- 20			V
<b>ゲート・ソースしゃ断電圧</b>	VGS(off)	V <sub>DS</sub> =5V, I <sub>D</sub> =1μA	- 0.2	- 0.6	- 1.2	V
<b>ドレイン電流</b>	I <sub>DSS</sub>	V <sub>DS</sub> =5V, V <sub>GS</sub> =0	150		380	μA
<b>順伝達アドミタンス</b>	y <sub>fs</sub>	V <sub>DS</sub> =5V, V <sub>GS</sub> =0, f=1kHz	0.5	1.2		mS
<b>入力容量</b>	C <sub>iss</sub>	V <sub>DS</sub> =5V, V <sub>GS</sub> =0, f=1MHz		3.5		pF
<b>帰還容量</b>	C <sub>rss</sub>	V <sub>DS</sub> =5V, V <sub>GS</sub> =0, f=1MHz		0.65		pF

次ページへ続く。

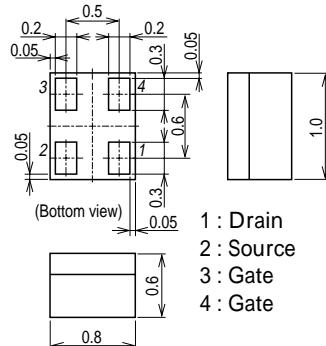
### 品名印刷表示(Top view)



The diagram illustrates a cross-section of a MOSFET. It features a rectangular substrate with a central channel region. The top surface is labeled 'Gate'. On the left side, there are two contact regions labeled 'Drain' and 'Source'. Dashed lines indicate the underlying structure, showing the source and drain regions extending downwards from the contacts.

外形図 2189

(unit : mm)



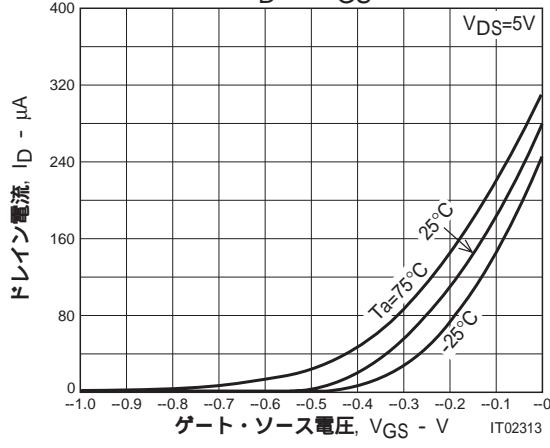
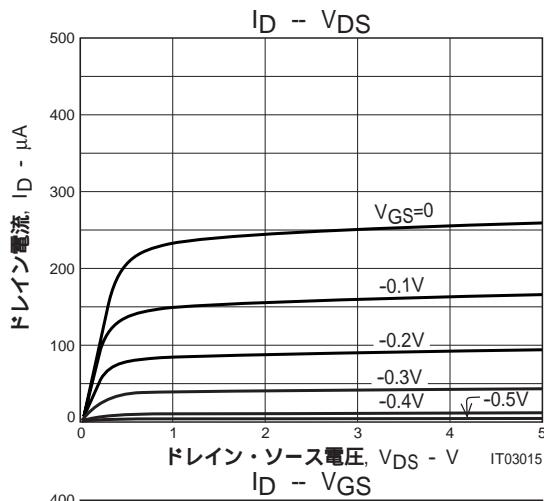
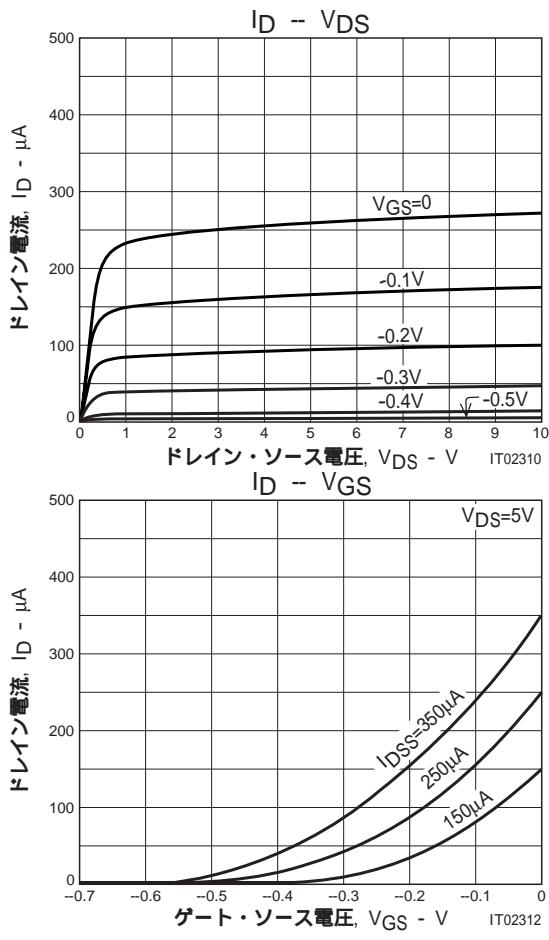
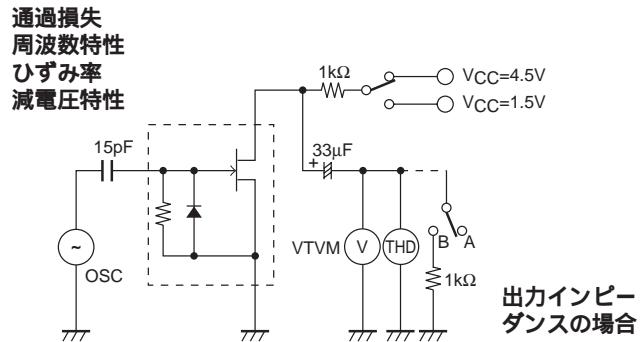
SANYO : E-CSP1008-4

- 本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を要する用途(生命維持装置、航空機のコントロールシステム等、多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様にはなっておりません。そのような場合には、あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下さい。
  - 本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲等)を瞬時たりとも越えて使用し、その結果発生した機器の欠陥について、弊社は責任を負いません。

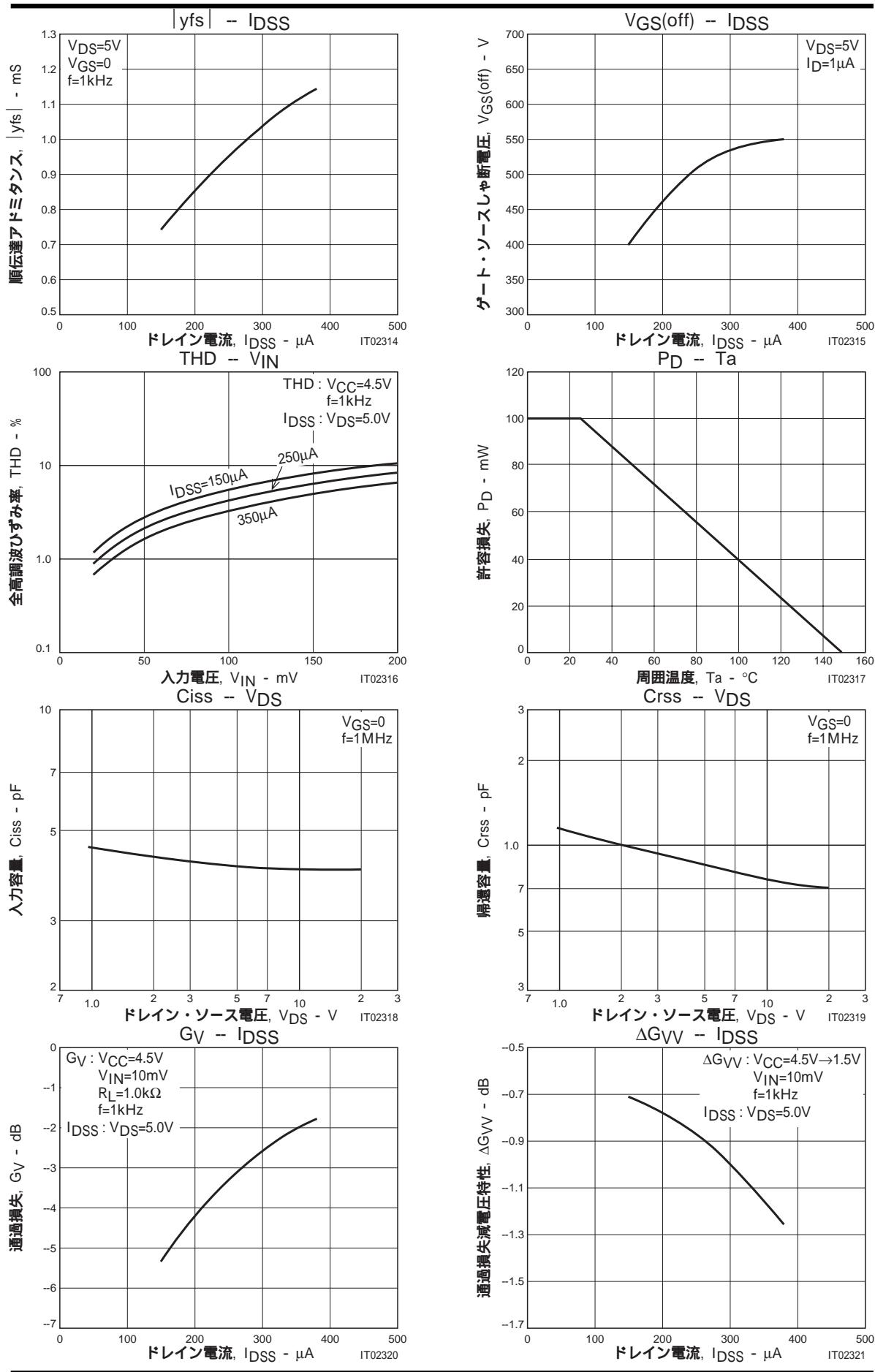
前ページより続く。

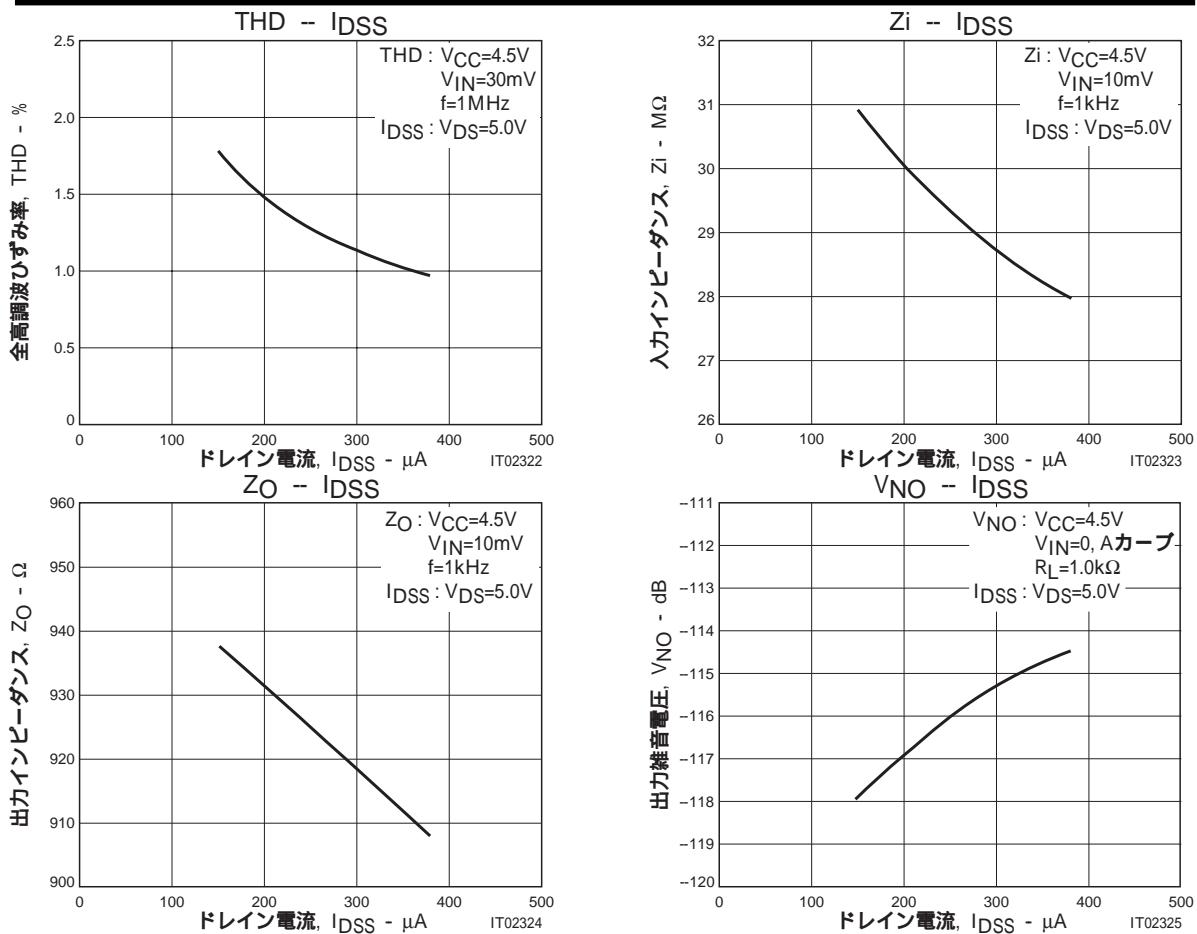
〔 $T_a=25^\circ\text{C}$ , $V_{CC}=4.5\text{V}$ , $R_L=1\text{k}\Omega$ , $C_{in}=15\text{pF}$ , 指定回路において〕		min	typ	max	unit
通過損失	$G_V$	$f=1\text{kHz}$ , $V_{IN}=10\text{mV}$	-	3.0	dB
減電圧特性	$\Delta G_{VV}$	$f=1\text{kHz}$ , $V_{IN}=10\text{mV}$	-	1.2	- 3.5 dB
		$V_{CC}=4.5\rightarrow 1.5\text{V}$			
周波数特性	$\Delta G_{f}$	$f=1\text{kHz} \sim 110\text{kHz}$		- 1.0	dB
入力インピーダンス	$Z_{IN}$	$f=1\text{kHz}$	25		$M\Omega$
出力インピーダンス	$Z_O$	$f=1\text{kHz}$		1000	$\Omega$
全高調波ひずみ率	THD	$f=1\text{kHz}$ , $V_{IN}=30\text{mV}$		1.2	%
出力雑音電圧	$V_{NO}$	$V_{IN}=0$ , A カーブ		- 110	dB

## 指定測定回路図



# EC4A01C





- 本書記載の製品は、定められた条件下において、記載部品単体の性能・特性・機能などを規定するものであり、お客様の製品（機器）での性能・特性・機能などを保証するものではありません。部品単体の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、お客様の製品で必要とされる評価・試験を必ず行って下さい。
- 弊社は、高品質・高信頼性の製品を供給することに努めています。しかし、半導体製品はある確率で故障が生じてしまいます。この故障が原因となり、人命にかかわる事故、発煙・発火事故、他の物品に損害を与える事故などを引き起こす可能性があります。機器設計時には、このような事故を起こさないような、保護回路・誤動作防止回路等の安全設計、冗長設計・機構設計等の安全対策を行って下さい。
- 本書記載の製品が、外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物（役務を含む）に該当する場合、輸出する際に同法に基づく輸出許可が必要です。
- 弊社の承諾なしに、本書の一部または全部を、転載または複製することを禁止します。
- 本書に記載された内容は、製品改善および技術改良等により将来予告なしに変更することがあります。したがって、ご使用の際には、「納入仕様書」でご確認下さい。
- この資料の情報（掲載回路および回路定数を含む）は一例を示すもので、量産セットとしての設計を保証するものではありません。また、この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用にあたって第3者の工業所有権その他の権利の実施に対する保証を行うものではありません。